

講演分科日程表 (分科別) I

早稲田大学

大分類分科名 中分類分科名	3月15日(木)		3月16日(金)		3月17日(土)		3月18日(日)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
本部共通行事								
応用物理学会業績賞・研究分野業績賞授賞式		M(小野記念講堂)18 16:30 ~ 17:30						
第12回応用物理学会 業績賞(研究業績)受賞記念講演/大野英男氏		A2 29 13:15 ~ 14:05						
第12回応用物理学会 業績賞(研究業績)受賞記念講演/西永頌氏		A2 29 14:10 ~ 15:00						
第31回応用物理学会講演奨励賞贈呈式	A2 18 11:30 ~ 12:10							
第13回光・量子エレクトロニクス 業績賞(宅間宏賞)受賞記念講演/武田光夫氏					B9 41 13:30 ~ 14:05			
第13回光・量子エレクトロニクス 業績賞(宅間宏賞)受賞記念講演/浜田恵美子氏			F4 53 10:30 ~ 11:05					
第9回光・電子集積技術 業績賞(林敏雄賞)受賞記念講演/小山二三夫氏			F3 53 13:30 ~ 14:05					
第2回化合物半導体エレクトロニクス 業績賞(赤崎勇賞)受賞記念講演/荒川泰彦氏					E1 99 10:30 ~ 11:05			
第2回女性研究者奨励育成 貢献賞(小箱香椎子賞)受賞記念講演/加藤一 実氏					F5 56 9:00 ~ 9:30			
シリコンテクノロジー分科会論文賞・研究奨励 賞授賞式						A1 96 13:15 ~ 13:30		
シリコンテクノロジー分科会論文賞受賞記念講 演						A1 96 13:30 ~ 13:55		
シリコンテクノロジー分科会研究奨励賞受賞記 念講演						A1 96 13:55 ~ 14:25		
特別シンポジウム 「応用物理とグリーンサイアティ ー発電、蓄電、送電、省電技術の現状と展望」		S(大隈講堂) 27 9:30 ~ 17:55						
特別シンポジウム 「元素戦略と応用物理」		E4 28 13:30 ~ 17:40						
海外研究者招待講演 6. 薄膜・表面/Jacobo Santamaria 氏				F2 61 15:00 ~ 15:30				
海外研究者招待講演 8. プラズマエレクトロニクス/Wonho Choe 氏			B8 70 10:30 ~ 11:15					
JJAP 創刊50周年記念講演 「JJAP これまでの50年、これからの50年」			A2 122 16:00 ~ 18:30					
博士のキャリア相談会					BC 123 11:30 ~ 16:00			
第50回スクール 「機能性酸化物入門～理論、加工・計測技術、 応用～」		C1 124 10:00 ~ 18:00						
第50回スクール 「半導体リソグラフィ技術の基礎」			C1 125 10:00 ~ 17:15					
応用物理学会諮問委員会		M(小野記念講堂)18 16:00 ~ 16:30						
懇親会		リーガロイヤルホテル東京 18 18:30 ~ 20:00						
1. 応用物理学一般								
関連シンポジウム		C3 29 13:30 ~ 18:15		C3 29 13:30 ~ 18:00				
		B4 34 13:30 ~ 16:30						
		F2 35 13:40 ~ 16:50						
1.1 応用物理一般					#C3 36 13:30 ~ 19:00	C3 36 9:00 ~ 11:45	C3 36 13:00 ~ 15:00	
1.2 教育			GP1 36 9:30 ~ 11:30					
1.3 新技術			C3 37 9:00 ~ 12:00		C3 37 9:00 ~ 12:00		GP1 37 9:30 ~ 11:30	
1.4 トライボロジー						GP1 37 9:30 ~ 11:30		
1.5 エネルギー変換・貯蔵					C2 37 13:30 ~ 14:30	GP2 38 9:30 ~ 11:30		
1.6 資源・環境					C2 38 14:45 ~ 16:15	GP3 38 9:30 ~ 11:30		
1.7 磁場応用						C2 38 9:00 ~ 12:00		
1.8 計測技術			#C2 38 13:30 ~ 16:00		GP10 38 15:30 ~ 17:30			
1.9 計測標準			C2 39 16:00 ~ 17:15		GP11 39 15:30 ~ 17:30			
2. 放射線								
関連シンポジウム		E7 35 13:30 ~ 17:10						
2.1 放射線物理一般・検出器基礎					C4 39 13:30 ~ 19:00	C4 39 9:00 ~ 12:30		
2.2 検出器開発			#C4 40 17:15 ~ 19:00	C4 40 9:00 ~ 12:00				
2.3 放射線応用・発生装置・新技術			C4 40 9:00 ~ 12:00	C4 40 13:30 ~ 17:00				

会場名のアルファベットは建物名を表します。
(例: A1はA棟(8号館)にあります。B2はB棟(7号館)にあります)
#分科内招待講演あり
関連シンポジウムは14, 15頁参照

<建物略称>

A: 8号館
B: 7号館
C: 10号館
DP: 11号館
E: 14号館
F: 15号館
GP: 興風館(早稲田中・高校)
S: 大隈講堂
M: 小野記念講堂

講演分科日程表について

(例)

3月15日(木)		3月16日(金)		3月17日(土)		3月18日(日)	
午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
A3(ショート) 10:00~12:15	→ポスター82 15:30~17:30	DP1 43 9:30~11:30	B5←34 9:00~12:00	C1 42 9:00~12:15	C1 42 13:15~17:00	F9 40 9:00~12:00	F9 40 13:00~14:30
amがショート講演, pm がポスターセッションの 例		ポスターセッ ションのみ	場所の記号 (B5会場)	講演時間		プログラム掲 載頁	

講演分科日程表 (分科別) II

早稲田大学

大分類分科名 中分類分科名	3月15日(木)		3月16日(金)		3月17日(土)		3月18日(日)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
3. 光								
関連シンポジウム		B9 34 13:00 ~ 17:45						
		B10 35 13:30 ~ 16:45			A2 41 10:00 ~ 11:15			
3.1 物理光学・光学基礎								
3.2 材料光学	#B9 41 9:00 ~ 12:00	GP4 41 13:30 ~ 17:30						
3.3 機器・デバイス光学	B10 41 10:00 ~ 11:45	GP5 41 13:30 ~ 17:30						
3.4 計測光学					GP1 42 9:30 ~ 11:30	#B9 41 13:30 ~ 18:05	B9 42 9:00 ~ 12:00	B9 42 13:00 ~ 15:00
3.5 情報光学			B10 42 9:00 ~ 12:00	#B10 43 14:00 ~ 19:00	GP2 43 9:30 ~ 11:30			
3.6 生体・医用光学			B9 43 9:00 ~ 12:00	B9 43 13:30 ~ 18:45	GP3 44 9:30 ~ 11:30			
3.7 近接場光学				GP1 44 13:00 ~ 15:00	B11 44 9:00 ~ 12:00	#B11 44 13:30 ~ 19:00	B11 45 9:00 ~ 12:00	B11 45 13:00 ~ 15:00
3.8 光学新領域					B9 45 9:00 ~ 12:00	GP1 45 13:00 ~ 15:00		
4. 量子エレクトロニクス								
関連シンポジウム		E3 33 13:00 ~ 17:30	E9 29 9:00 ~ 12:30					
4.1 量子光学・原子光学						GP2 46 13:00 ~ 15:00	E3 46 9:00 ~ 12:15	
4.2 フォトニックナノ構造・現象	GP1 46 9:30 ~ 11:30	E5 46 13:30 ~ 18:00	E5 47 9:30 ~ 11:45	E5 47 13:30 ~ 17:00				
4.3 レーザ装置・材料		GP6 47 15:30 ~ 17:30		E9 48 13:45 ~ 19:00	E9 48 9:00 ~ 12:00			
4.4 超高速・高強度レーザー					GP4 49 9:30 ~ 11:30	#E9 48 13:30 ~ 18:15	E9 49 9:00 ~ 12:00	E9 49 13:00 ~ 15:00
4.5 テラヘルツ全般・非線形光学	GP2 49 9:30 ~ 11:30		E8 49 9:00 ~ 12:00	E8 50 13:30 ~ 18:45	E8 50 9:00 ~ 12:00	E8 50 13:30 ~ 18:45	E8 51 9:00 ~ 12:15	
4.6 レーザー分光応用・計測						GP3 51 13:00 ~ 15:00		E3 51 13:00 ~ 15:00
4.7 レーザー・プロセッシング	#E6 51 9:00 ~ 12:00	GP7 52 13:30 ~ 17:30	E6 52 9:00 ~ 12:15	#E6 52 13:30 ~ 18:45				
5. 光エレクトロニクス								
関連シンポジウム		F9 32 13:00 ~ 16:45						
		F4 33 13:00 ~ 17:30						
5.1 半導体レーザー・発光/受光素子			F3 53 9:00 ~ 12:00	**F3 53 13:30 ~ 17:45		GP12 53 15:30 ~ 17:30		
5.2 光記録/ストレージ			*F4 53 9:00 ~ 11:50					
5.3 光制御			#F4 54 13:30 ~ 18:30	F4 54 9:00 ~ 12:00	F4 54 13:30 ~ 18:45	F4 54 9:00 ~ 12:00	F4 54 13:00 ~ 15:00	F4 55 9:30 ~ 11:30
5.4 光ファイバー					#F3 55 9:00 ~ 12:00	GP13 55 15:30 ~ 17:30		
6. 薄膜・表面								
関連シンポジウム		F3 32 13:00 ~ 17:10				F5 30 13:45 ~ 18:00		
		F5 35 13:30 ~ 16:40						
6.1 強誘電体薄膜				GP2 56 13:00 ~ 15:00	**F5 56 9:00 ~ 12:15		F5 56 9:00 ~ 12:00	F5 56 13:00 ~ 15:00
6.2 コーボン系薄膜					GP5 57 9:30 ~ 11:30	#F3 57 13:30 ~ 17:45	F3 57 9:00 ~ 12:00	F3 58 13:00 ~ 15:00
6.3 酸化物エレクトロニクス	GP3 58 9:30 ~ 11:30		F6 58 9:00 ~ 12:00	F6 59 13:30 ~ 18:45	F6 59 9:00 ~ 12:00	F6 59 13:30 ~ 18:45	F6 60 9:00 ~ 12:00	F6 60 13:00 ~ 15:00
6.4 薄膜新材料			F2 60 9:00 ~ 12:30	#F2 61 13:30 ~ 18:15	F2 61 9:30 ~ 12:00			
					GP6 61 9:30 ~ 11:30			
6.5 表面物理・真空					GP7 62 9:30 ~ 11:30	F2 61 13:30 ~ 17:45	F2 62 9:00 ~ 12:00	F2 62 13:00 ~ 15:00
6.6 フローブ顕微鏡	F5 62 9:00 ~ 12:00		F5 62 9:00 ~ 12:00	F5 63 13:30 ~ 18:00		GP4 63 13:00 ~ 15:00		
7. ビーム応用								
関連シンポジウム	B8 31 9:30 ~ 15:15							
		A4 32 13:00 ~ 17:00						
		B11 33 13:00 ~ 17:15						
7.1 X線技術						DP1 63 13:00 ~ 15:00	B5 63 9:00 ~ 12:00	B5 64 13:00 ~ 14:30
7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析				B5 64 13:30 ~ 17:15				
7.3 リソグラフィ						DP2 64 13:00 ~ 15:00	A4 64 9:00 ~ 12:00	A4 64 13:00 ~ 14:15
7.4 ナノインプリント							A2 65 9:00 ~ 12:00	A2 65 13:00 ~ 15:00
7.5 ビーム・光励起表面反応							B6 65 9:00 ~ 11:00	
7.6 イオンビーム一般				DP1 65 13:00 ~ 15:00	B5 65 10:45 ~ 12:00	B5 66 13:30 ~ 18:30		
7.7 微小電子源			B5 66 9:00 ~ 12:00					
7.8 ビーム応用一般・新技術							B6 66 11:00 ~ 11:30	

会場名のアルファベットは建物名を表します。
 (例: A1はA棟(8号館)にあります。B2はB棟(7号館)にあります)
 *第13回光・量子エレクトロニクス業績賞(宅間宏賞)受賞記念講演あり
 **第9回光・電子集積技術業績賞(林殿雄賞)受賞記念講演あり
 ※第2回女性研究者奨励育成員貢献賞(小舘香椎子賞)受賞記念講演あり
 # 分科内招待講演あり
 ## 海外研究者招待講演あり
 関連シンポジウムは14, 15頁参照

<建物略称>

A: 8号館
 B: 7号館
 C: 10号館
 DP: 11号館
 E: 14号館
 F: 15号館
 GP: 興風館(早稲田中・高校)
 S: 大隈講堂
 M: 小野記念講堂

講演分科日程表 (分科別) III

早稲田大学

大分類分科名 中分類分科名	3月15日(木)		3月16日(金)		3月17日(土)		3月18日(日)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
8. プラズマエレクトロニクス								
関連シンポジウム		E8 35 13:50 ~ 17:15						
8 分科内招待講演			#B8 70 11:15 ~ 12:15					
8 プラズマエレクトロニクス			A6 (ショート) →ポスター-GP 66 9:00 ~ 9:40:13:00 ~ 15:00		A7 (ショート) →ポスター-DP 67 9:00 ~ 9:46:15:30 ~ 17:30			
8.1 プラズマ生成・制御			A7 67:A7 67 9:00 ~ 10:15:13:15 ~ 18:45					
8.2 プラズマ診断・計測					B8 68 13:15 ~ 15:15	A7 68 9:00 ~ 11:45		
8.3 プラズマ成膜・表面処理					B8 68 15:30 ~ 18:45	B8 68 9:00 ~ 12:00		
8.4 プラズマエッチング					A7 69:A7 69 11:00 ~ 12:00:13:30 ~ 18:45			
8.5 プラズマナノテクノロジー			A6 69 15:30 ~ 18:30					
8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野			#B8 70:B8 70 9:00 ~ 11:15:13:00 ~ 19:00		B8 70 9:45 ~ 12:00			
9. 応用物性								
関連シンポジウム		B2 31 9:30 ~ 16:50						
		B3 33 13:00 ~ 17:45						
9.1 誘電材料・誘電体			B3 71 15:45 ~ 19:00					
			GP3 71 13:00 ~ 15:00					
9.2 微粒子・粉体							B3 71 13:00 ~ 15:00	
9.3 ナノエレクトロニクス	B3 71 9:00 ~ 12:00		B3 71:B3 72 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 15:30					
			DP3 72 15:30 ~ 17:30					
9.4 熱電変換			DP2 72 13:00 ~ 15:00	B3 72:B3 73 9:30 ~ 11:30:13:30 ~ 17:45				
9.5 新機能材料・新物性					DP5 73 15:30 ~ 17:30	B3 73 9:00 ~ 11:30		
10. スピントロニクス・マグネティクス								
関連シンポジウム		A3 35 13:30 ~ 18:10						
10.1 新物質創成 (酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)			B4 73:B4 73 9:00 ~ 12:00:13:00 ~ 16:30	DP1 74 9:30 ~ 11:30				
10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術			DP4 74 15:30 ~ 17:30	B4 74:B4 75 9:00 ~ 12:15:13:30 ~ 18:15				
10.3 GMR・TMR・磁気記録技術				DP2 75 9:30 ~ 11:30		B4 75:B4 75 9:00 ~ 12:00:13:00 ~ 15:00		
10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス			B11 76:B11 76 9:30 ~ 11:45:12:45 ~ 18:30	DP3 76 9:30 ~ 11:30				
11. 超伝導								
関連シンポジウム	B7 30:B7 35 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 17:15		#B7 77:#B1 78 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 15:15					
11.1 基礎物性			#B7 77:B7 77 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 17:45	B7 77:GP5 77 9:00 ~ 12:00:13:00 ~ 15:00				
11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長			B1 78:#B1 78 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 17:30		GP6 78 13:00 ~ 15:00			
11.3 臨界電流、超伝導パワー応用					B7 78 13:30 ~ 17:45			
11.4 アナログ応用および関連技術			GP8 79 15:30 ~ 17:30	B1 79:B1 79 9:00 ~ 11:45:13:30 ~ 16:00				
11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用					GP7 79 13:00 ~ 15:00	B7 79 9:00 ~ 12:15		
12. 有機分子・バイオエレクトロニクス								
関連シンポジウム		F8 34 13:30 ~ 16:15	F7 30 9:00 ~ 12:00					
12.1 作製技術	F7 80:F7 80 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 18:00				F7 80:GP8 81 9:00 ~ 12:00:13:00 ~ 15:00			
12.2 評価・基礎物性		GP8 81 15:30 ~ 17:30	F10 81:F10 81 10:00 ~ 12:00:13:30 ~ 18:00					
12.3 電子機能材料・デバイス		GP9 82 15:30 ~ 17:30	E7 82:#E7 82 10:00 ~ 12:00:13:30 ~ 15:30					
12.4 光機能材料・デバイス					GP14 82 15:30 ~ 17:30	F9 82:F9 82 9:00 ~ 12:00:13:00 ~ 14:15		
12.5 液晶					GP9 83 13:00 ~ 15:00	F8 83:F8 83 9:00 ~ 12:00:13:00 ~ 15:00		
12.6 高分子・ソフトマテリアル		F1 83 13:00 ~ 14:30						
		GP10 83 15:30 ~ 17:30						
12.7 生物・医用工学・バイオチップ			F8 83:F8 84 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 18:45	F8 84:F8 84 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 18:00	GP5 85 9:30 ~ 11:30			
12.8 有機EL				GP8 85:F7 85 9:30 ~ 11:30:13:30 ~ 18:00	F7 85 9:00 ~ 11:45			
12.9 有機トランジスタ		GP11 86 15:30 ~ 17:30	F9 86:F9 86 9:00 ~ 11:30:13:00 ~ 17:45	F9 87:F9 87 9:00 ~ 11:30:13:00 ~ 15:30				
12.10 ナノバイオテクノロジー			F1 87:#F1 88 9:00 ~ 12:30:14:00 ~ 18:00	F1 88:GP15 88 9:15 ~ 12:00:15:30 ~ 17:30				
12.11 特定テーマ「有機太陽電池」	F10 88:F1 89 9:00 ~ 12:00:15:00 ~ 18:00		F7 89 13:00 ~ 15:00	F10 90:#F10 90 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 18:30		F10 90:F10 90 9:00 ~ 12:00:13:00 ~ 15:00		
			GP9 89 15:30 ~ 17:30					
12.12 特定テーマ「次元制御有機ナノ材料」				GP9 91:F1 91 9:30 ~ 11:30:13:30 ~ 18:00	F1 91:F1 91 9:00 ~ 12:00:13:00 ~ 14:15			

会場名のアルファベットは建物名を表します。
 (例: A1 は A 棟 (8号館) にあります。 B2 は B 棟 (7号館) にあります)
 # 分科内招待講演あり
 ## 海外研究者招待講演あり
 関連シンポジウムは 14、15 頁参照

<建物略称>

- A : 8号館
- B : 7号館
- C : 10号館
- DP : 11号館
- E : 14号館
- F : 15号館
- GP : 興風館 (早稲田中・高校)
- S : 大隈講堂
- M : 小野記念講堂

講演分科日程表 (分科別) IV

早稲田大学

大分類分科名 中分類分科名	3月15日(木)		3月16日(金)		3月17日(土)		3月18日(日)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13. 半導体 A (シリコン)								
関連シンポジウム	F6 30 9:00 ~ 17:45				A5 30 13:30 ~ 17:10			
13.1 基礎物性・評価					GP16 91 15:30 ~ 17:30	A1 92	A1 92	A1 92
13.2 半導体表面			A5 92 9:00 ~ 11:45	GP4 92 13:00 ~ 15:00				
13.3 絶縁膜技術		GP1 92 13:00 ~ 15:00	A4 93 13:30 ~ 17:45	A4 93 13:30 ~ 17:45	A4 93 9:15 ~ 11:45	A4 93 13:30 ~ 18:45		
13.4 配線技術					GP10 94 9:30 ~ 11:30		A5 94 9:00 ~ 12:00	
13.5 Si プロセス技術				GP5 94 13:00 ~ 15:00	A6 95 9:00 ~ 12:00	A6 95 13:30 ~ 17:15	A6 95 9:00 ~ 12:00	
13.6 Si デバイス/集積化技術			A1 95 9:00 ~ 11:30	A1 95 13:00 ~ 18:15	A1 96 9:00 ~ 12:00	A1 96 13:30 ~ 17:55	GP6 97 9:30 ~ 11:30	
13.7 シミュレーション			GP2 97 9:30 ~ 11:30	A5 97 13:30 ~ 16:30				
14. 半導体 B (探索的材料・物性・デバイス)								
関連シンポジウム	E2 31 9:00 ~ 17:55							
		A1 32 13:00 ~ 16:25						
		E9 34 13:00 ~ 17:45						
		E1 34 13:05 ~ 17:40						
14.1 探索的材料物性			#E1 97 9:00 ~ 12:00	E1 98 13:30 ~ 18:45		GP17 98 15:30 ~ 17:30		E1 98 13:00 ~ 15:00
14.2 超薄膜・量子ナノ構造			GP6 99 13:00 ~ 15:00	**E1 99 13:00 ~ 15:00	GP18 99 9:00 ~ 11:50	E1 99 13:30 ~ 18:45	E1 100 9:00 ~ 12:00	
14.3 プロセス技術・界面制御					GP18 100 15:30 ~ 17:30	E2 100 9:00 ~ 11:45	E2 100 13:00 ~ 14:15	
14.4 超高速・機能デバイス					E3 100 9:00 ~ 12:00	E3 100 13:30 ~ 16:45	GP7 101 9:30 ~ 11:30	
14.5 光物性・発光デバイス		E2 101 9:00 ~ 11:45	E2 101 13:30 ~ 18:45	E2 101 13:30 ~ 18:45	E2 101 9:00 ~ 12:15	E2 102 13:45 ~ 18:45	GP8 102 9:30 ~ 11:30	
14.6 化合物太陽電池			GP7 102 13:00 ~ 15:00	C1 103 9:00 ~ 12:00	C1 103 13:00 ~ 18:30	C1 103 9:00 ~ 11:45	C1 103 13:00 ~ 14:30	
15. 結晶工学								
関連シンポジウム	F11 32 9:30 ~ 18:00							
		F10 33 13:00 ~ 17:15						
15.1 バルク結晶成長					F11 104 9:00 ~ 12:30	DP6 104 15:30 ~ 17:30		
15.2 II-VI 族結晶					DP7 104 15:30 ~ 17:30		F11 104 9:00 ~ 11:45	
15.3 III-V 族エピタキシャル結晶			A8 104 9:00 ~ 12:30	A8 105 14:00 ~ 18:30	A8 105 9:00 ~ 12:00	DP3 105 13:00 ~ 15:00		
15.4 III-V 族窒化物結晶		F12 106 13:00 ~ 17:45	DP1 107 9:30 ~ 11:30	F12 106 12:45 ~ 18:30	F12 108 9:00 ~ 12:00	F12 108 13:15 ~ 18:45	F12 108 9:00 ~ 12:00	F12 109 13:00 ~ 15:00
15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶			F11 109 10:45 ~ 12:00	F11 109 13:30 ~ 18:45	DP4 109 9:30 ~ 11:30			
15.6 IV 族系化合物					DP5 110 9:30 ~ 11:30	A8 110 13:30 ~ 18:00	A8 110 9:00 ~ 12:00	A8 110 13:00 ~ 14:45
15.7 エピタキシーの基礎			F11 111 9:00 ~ 10:30		DP4 111 13:00 ~ 15:00			
15.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥					F11 111 13:30 ~ 18:00			
16. 非晶質・微結晶								
関連シンポジウム			F7 30 9:00 ~ 12:00					
16.1 基礎物性・評価			B6 111 9:30 ~ 11:45	B6 111 13:30 ~ 18:45	GP11 112 9:30 ~ 11:30			
16.2 プロセス技術・デバイス						B6 112 13:30 ~ 17:45		
16.3 シリコン系太陽電池				GP10 112 15:30 ~ 17:30	B6 112 9:00 ~ 12:00	B10 113 13:00 ~ 19:00	B10 113 9:00 ~ 12:00	B10 113 13:00 ~ 15:00
17. ナノカーボン								
17 ナノカーボン	A3 (ショート) →ポスター 10:00 ~ 11:30	DP 114 13:00 ~ 15:00						
17.1 成長技術			A3 114 9:00 ~ 12:00	A3 115 13:30 ~ 19:00	A3 115 9:00 ~ 12:00			
17.2 構造制御・プロセス						A3 115 13:30 ~ 18:45		
17.3 新機能探索・基礎物性評価			B2 116 9:00 ~ 12:00	B2 116 13:30 ~ 17:30	B2 116 9:15 ~ 12:00			
17.4 デバイス応用						B2 116 13:30 ~ 18:45	B2 117 9:00 ~ 12:45	
合同セッション								
合同セッション K「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」	GP2 117 13:00 ~ 15:00	E4 118 9:30 ~ 12:00	E4 118 13:30 ~ 19:00	E4 118 13:30 ~ 19:00	E4 118 9:00 ~ 12:00	E4 118 13:30 ~ 19:00		
合同セッション L (MEMS, NEMS の基礎と応用: 異種機能集積化)	GP3 119 13:00 ~ 15:00	E3 120 9:00 ~ 12:00	E3 120 13:30 ~ 19:00					

会場名のアルファベットは建物名を表します。
 (例: A1 は A 棟 (8号館) にあります。 B2 は B 棟 (7号館) にあります)
 ※※: 第2回化合物半導体エレクトロニクス業績賞 (赤崎勇賞) 受賞記念講演あり
 # 分科内招待講演あり
 関連シンポジウムは 14, 15 頁参照

<建物略称>
 A: 8号館
 B: 7号館
 C: 10号館
 DP: 11号館
 E: 14号館
 F: 15号館
 GP: 興風館 (早稲田中・高校)
 S: 大隈講堂
 M: 小野記念講堂